Электронное строение монокристаллических феррита висмута и гематита: рентгеноэлектронное исследование и расчет

© А.Т. Козаков¹, К.А. Гуглев¹, В.В. Илясов², И.В. Ершов², А.В. Никольский¹, В.Г. Смотраков¹, В.В. Еремкин¹

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия ² Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

(Поступила в Редакцию 13 апреля 2010 г.)

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с монохроматизацией рентгеновского излучения AIK_{α} -линии на приборе ESCALAB 250 с поверхности монокристаллов BiFeO₃ и Fe₂O₃ получены рентгеноэлектронные спектры внутренних уровней и валентных полос. Полнопотенциальным методом псевдопотенциала в рамках теории функционала плотности (программный пакет Quantum-Espresso) выполнены *ab initio* расчеты. Расчеты зонной структуры, полных и парциальных плотностей электронных состояний проведены для систем BiFeO₃ и Fe₂O₃. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов показало хорошее согласие терии и эксперимента.

Работа выполнена в рамках бюджетной тематики НИИ физики ЮФУ.

1. Введение

04

Феррит висмута BiFeO₃ является наиболее известным сегнетомагнетиком (мультиферроиком), сочетающим в себе сегнетоэлектрические и магнитные свойства. Он относится к структурному типу перовскита и при комнатной температуре имеет ромбоэдрически искаженную прототипическую ячейку с пространственной группой симметрии R3c. На ромбоэдрическую элементарную ячеку приходятся две формульные единицы [1]. Температура перехода из сегнетоэлектрического в параэлектрическое состояние составляет $T_c = 830^{\circ}$ С, а из антиферромагнитного в парамагнитное — $T_N = 370^{\circ}$ С [2].

Гематит (α -Fe₂O₃) имеет ромбоэдрическую кристаллическую структуру корунда с Fe³⁺-катионами, расположенными в искаженном кислородном октаэдре ромбоэдрической решетки [3,4]. Расстояния между железом, расположенным приблизительно в центре октаэдра, и атомами кислорода, которые смещены от позиции правильного октаэдра, по разным данным составляют 1.95–1.945 и 2.08–2.11 Å [3,4].

Кристаллическую структуру BiFeO₃ можно представить как состоящую из октаэдрических комплексов FeO₆, соединенных вершинами, с расположенными в полостях между октаэдрами ионами висмута. Октаэдры значительно искажены, а ион Bi сильно сдвинут из центрального положения в сторону одного из ионов железа [5]. Атом железа также смещен относительно центра окружающего его октаэдра, так что он имеет три атома кислорода, расположенных на расстоянии 1.96 Å, и три — 2.11 Å. Из этих данных видно, что одна из существенных структурных единиц гематита (октаэдр FeO₆), практически не меняя своих размеров, образует структурную единицу феррита висмута.

Электронное строение феррита висмута BiFeO₃ в последние годы было предметом ряда теоретических и

экспериментальных исследований [5–13]. Большое число теоретических работ посвящено изучению электронной структуры BiFeO₃ и связи ее особенностей с его магнитоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами [5–8,10,12,13]. В то же время имеется ограниченное число экспериментальных данных по электронному строению BiFeO₃ [9,11,13], в основном это рентгеновские эмиссионные и абсорбционные спектры валентных полос [9,11]. Рентгеноэлектронные данные по нашим сведениям пока отсутствуют.

По электронному строению оксидов железа, в том числе α -Fe₂O₃, также имеется ряд экспериментальных и теоретических работ [11,14–18], причем теоретический подход к объяснению деталей валентной полосы варьируется от зонного метода [15–17] до расчета мультиплета от конечных состояний, возникающих при удалении электрона из валентной полосы [18].

Целью настоящей работы является исследование электронного строения $BiFeO_3$ и α - Fe_2O_3 в рамках одного эксперимента методом рентгеноэлектронной спектроскопии и одного теоретического подхода — *ab initio* расчета электронной структуры методом функционала плотности.

2. Эксперимент

Приготовление однофазного BiFeO₃ затруднено из-за сложности фазовой диаграммы системы $Bi_2O_3 - Fe_2O_3$, допускающей формирование еще двух бинарных соединений $Bi_2Fe_4O_9$ и $Bi_{25}FeO_{39}$ [19,20], летучести Bi_2O_3 выше точки своего плавления [21] и термодинамической нестабильности BiFeO₃ на воздухе в отсутствие равновесного раствора-расплава Bi_2O_3/Fe_2O_3 [20]. По данным [22,23] BiFeO₃ разлагается начиная с 700°С.

Согласно [20], скорость разложения зависит от множества факторов, таких как температура, время выдержки при заданной температуре, скорость нагрева, число дислокаций на поверхности, соотношение поверхности и объема, пористость и размер зерна керамики и т.д. В частности, при термической обработке тонкодисперсных (~ 120 nm) порошков, полученных золь-гель-методом [24], процесс разложения BiFeO₃ с образованием Bi₂Fe₄O₉ и Bi₂₅FeO₃₉ происходит уже при 600°С. По этим причинам для исследования BiFeO₃ желательно использовать монокристаллы. Кристаллизация из раствора-расплава Bi2O3-Fe2O3 приводит к формированию дендритных форм [25,26]. Добавление Ві2О3 позволяет снизить температуру выращивания, однако не меняет габитус кристаллов, при этом увеличение времени кристаллизации способствует формированию Bi₂Fe₄O₉ [27]. Кристаллы BiFeO₃ псевдокубического габитуса могут быть получены из раствора-расплава 0.756 wt.% Bi2O3-0.179 wt.% Fe2O34-0.065 wt.% NaCl [28,29].

В качестве объектов исследования использовались монокристаллы кубической формы с размером ребра ~ 1 mm, выращенные в температурном диапазоне кристаллизации 930–820°С по методике, описанной в [28]. Из раствора-расплава $Bi_2O_3-Fe_2O_3-B_2O_3$ (89.6:7.7:2.7 wt.%), предложенного в [27], в диапазоне от 850 до 620°С при скорости охлаждения 5°С/h получены дендритные формы кристаллов BiFeO_3. Кроме того, в интервале температур 1000–850°С из системы $Bi_2O_3-Fe_2O_3-B_2O_3$ (82.4:13.1:4.5 wt.%) получены черные изометрические кристаллы Fe_2O_3 псевдокубического габитуса со структурой гематита.

Рентгеноэлектронные спектры с поверхности Fe₂O₃ и BiFeO₃ исследовались с помощью рентгеновского фотоэлектронного микрозонда ESCALAB 250. Возбуждение рентгеноэлектронных спектров осуществлялось с помощью монохроматизированного излучения А1К_а-линии. Абсолютный разрешимый интервал энергии составлял 0.5 eV, который определялся по $Ag3d_{5/2}$ -рентгеноэлектронной линии. Диаметр рентгеновского пятна на образце составлял 500 µm и был достаточен для исследования полученных образцов. Для снятия положительной зарядки на образце использовались такие методы нейтрализации поверхности образца, как облучение образца совместно потоками медленных электронов и ионов. Свободная от загрязнений поверхность монокристалла создавалась скрайбированием монокристалла алмазным надфилем в вакууме в камере подготовки образца при давлении порядка 1 · 10⁻⁶ Ра. Контроль состояния поверхности осуществлялся по форме Bi4f-, O1s-рентгеноэлектронных линий для феррита висмута и O1s-рентгеноэлектронной линии для гематита. Содержание углерода на поверхности обоих монокристаллов было исчезающе малым: C1s-рентгеноэлектронная линия едва превышала уровень фона. На рис. 1 приведены Bi4f- и O1s-рентгеноэлектронные линии с поверхности BiFeO₃ (puc. 1, a u b cootBetterBetho) u O1s-pentrehoэлектронная линия Fe_2O_3 (рис. 1, *c*). По линиям дублета



Рис. 1. Рентгеноэлектронные спектры $Bi4f_{5/2,7/2}(a)$, O1s (b) с чистой поверхности монокристалла $BiFeO_3$ и O1s (c) с чистой поверхности монокристалла Fe_2O_3 .

Ві4 $f_{5/2,7/2}$ видно, что висмут находится в одном химическом состоянии. Разложение на компоненты O1s-линий свидетельствует о том, что наряду с линией кислорода Aв связи с металлом имеется также компонента небольшой интенсивности B со стороны больших энергий связи, которую можно отнести к адсорбированному кислороду или поверхностным эффектам [30]. Независимо от интерпретации полагают, что количество кислорода, соответствующее интенсивности этой линии, не искажает результатов рентгеноэлектронных исследований [30]. Энергия связи Bi4 $f_{7/2}$ -электронного уровня составляет 158.6 eV, что характеризует связь висмута с кислородом. Энергии связи O1s-уровней в соединениях BiFeO₃ и Fe₂O₃, равные 529.5 eV, характеризуют связи кислорода с металлами в феррите висмута и гематите.

Измеренный по рентгеноэлектронным спектрам элементный состав поверхности для монокристалла BiFeO₃ составляет: Bi — 20.2 at.%, Fe — 19.1 at.%, O — 60.7 at.%, т.е. соответствует формуле Bi_{1.01}Fe_{0.96}O_{3.03}; для Fe₂O₃: Fe — 42.5 at.%, O — 57.5 at.%, или в виде формулы Fe_{2.1}O_{2.9}, что близко к составам соответственно феррита висмута и гематита.

3. Расчет плотности состояний

Аb initio расчеты были выполнены полнопотенциальным методом псевдопотенциала в рамках теории функционала плотности (программный пакет Quantum-Espresso) [31–33]. Проведены расчеты зонной структуры, полных и парциальных плотностей электронных состояний (DOS) для систем BiFeO₃ и Fe₂O₃. При моделировании структуры BiFeO₃ и спользовалась гексагональная суперьячейка с 30 базисными атомами, фрагмент которой представлен на рис. 2. В качестве расчетной ячейки Fe₂O₃ была выбрана примитивная ромбоэдрическая ячейка. Для описания электронно-ионного взаимодействия в обоих случаях использовались псевдопотенциалы, сохраняющие нормировку. Для обменнокорреляционных функционалов использовалось выражение в форме PBE [33] в рамках обобщенной градиентной



Рис. 2. Фрагмент структуры BiFeO₃, используемый при расчете.

аппроксимации (GGA). Для разложения электронных волновых функций по плоским волнам была выбрана энергия обрезания, равная 950 eV. Для процедуры интегрирования в обратном пространстве использовалась сетка специальных k-точек, которая соответствовала 20 неэквивалентным векторам в неприводимой части зоны Бриллюэна для BiFeO3 и 28 неэквивалентным векторам для Fe₂O₃. Полученная общая плотность состояний хорошо согласуется с данными расчета [16]. Однако в [16] расчет сделан только в области от 0 до $-5 \,\text{eV}$, в то время как наш расчет дает как общую плотность валентных состояний гематита протяженностью до 10 eV, так и парциальные плотности состояний кислорода и железа. Расчет плотности состояний в большем энергетическом интервале позволяет провести более полное сравнение с экспериментом.

4. Обсуждение результатов

На рис. 3 приведены экспериментальный необработанный спектр валентной полосы монокристаллического Fe₂O₃ и рассчитанная плотность состояний. Ширина рентгеноэлектронного спектра валентной полосы по основанию составляет 8.7 eV, что на 0.6 eV уже, а тонкая структура спектра в области 0-9 eV лучше разрешена по сравнению с [18]. Полученный нами рентгеноэлектронный спектр валентной полосы гематита состоит из четырех максимумов, которые обозначены на рисунке А, В, С, Д. Тонкая структура рентгеноэлектронного спектра монокристалла Fe₂O₃, полученная в [18], также состоит из четырех особенностей. Энергетическое положение деталей тонкой структуры рентгеноэлектронного спектра валентной полосы монокристалла Fe₂O₃ относительно положения низкоэнергетического края в нашем эксперименте составляет: А — 1.3 eV, В — 3.3 eV, C — 5.6 eV, D — 11.9 eV. Соответствующие энергетические положения деталей тонкой структуры рентгеноэлектронного спектра валентной полосы монокристалла Fe₂O₃, полученные в [18], равны 2.2, 4.8, 6.5, 12.2 eV. Максимум D является достаточно широким, и его точное положение определить трудно. Меньшая ширина основного максимума (8.7 eV) нашего спектра и лучше разрешенная тонкая структура объясняются тем, что наш эксперимент выполнялся с монохроматизированным рентгеновским излучением, а в [18] с использованием немонохроматизированного излучения MgK_a-линии. Разница в положении деталей тонкой структуры в нашем спектре и в спектре [18] объясняется разной подготовкой образцов для рентгеноэлектронного эксперимента. В [18] для того, чтобы избежать при съемке эффектов зарядки, монокристалл Fe₂O₃ нагревался на воздухе ири $T = 1390^{\circ}$ С в течение 17 h, в результате чего в образце появилась фаза Fe₃O₄ в количесте около 10%. В камере образца поверхность монокристалла обрабатывалась алмазным надфилем. Мы также обрабатывали поверхность монокристалла в вакууме алмазным надфилем, а для устранения эффектов зарядки использовали возможности прибора, которые отсутствовали в



Рис. 3. Экспериментальный рентгеновский фотоэмиссионный спектр монокристалла Fe_2O_3 (1), сопоставленный с рассчитанной общей плотностью состояний валентной полосы (2).

приборе [18]. Это означает, что нами измерялся спектр с поверхности только монокристаллического Fe_2O_3 без примеси Fe_3O_4 .

На рис. 3 плотность состояний совмещена с экспериментальным спектром так, чтобы уровень Ферми, совмещенный с низкоэнергетическим краем рассчитанной валентной зоны, проходил через середину низкоэнергетического склона экспериментального спектра. Первые три максимума (A, B, C) при выбранном совмещении хорошо согласуются с соответствующими тремя максимумами в рассчитанной плотности состояний. Максимум *D* зонным расчетом не воспроизводится. Как следует из [18], его происхождение определяется мультиплетом конечного состояния конфигурации $Fe3d^4$. В работе [18] оспаривается возможность описания и верхней части валентной полосы в области 0-9 eV в зонном приближении. Согласно [18], основной вклад в эту область дают конечные состояния мультиплета конфигурации d⁵L где L — обозначает экранирующий заряд с лигандов, которыми являются атомы кислородного окружения. Согласие энергетического положения максимумов А, В, С в экспериментальном спектре с соответствующими максимумами в рассчитанной нами плотности состояний свидетельствует о том, что электронная структура гематита может быть достаточно хорошо описана и в зонном приближении. На рис. 4 сопоставлены исправленный на фон рентгеноэлектронный спектр валентной полосы Fe₂O₃ и парциальные плотности состояний Fe₂O₃, относящиеся к распределению в валентной полосе Fe3d- и O2p-электронных состояний. Видно, что Fe3d- и O2p-электронные состояния сильно гибридизированы и в валентной полосе нельзя выделить области, формируемые электронными состояниями либо только железа, либо кислорода. В то же время в каждой из областей валентной полосы, занятой р-состояниями кислорода и *d*-состояниями железа, вклад состояний железа приблизительно в 2 раза больше. Сечения ионизации Fe3d-электронов больше примерно в 1.3 сечений ионизации O2s-электронов [34]. В целом, эта оценка позволяет определить, что вклад Fe3d-электронных состояний в экспериментальный спектр более чем в 2.5 раза превышает вклад O2s-электронов. Общая ширина рассчитанной плотности занятых состояний составляет около 7.2 eV, что с учетом экспериментального уширения хорошо согласуется с шириной главного максимума рентгеноэлектронного спектра. Рассчитанная ширина запрещенной зоны составляет 0.85 eV, в то время как экспериментально определенная величина значительно больше 2–2.7 eV [18]. Таким образом, расчет достаточно хорошо описывает главный максимум по энергетической ширине, по количеству и положению деталей тонкой структуры А, В, С. В расчете не воспроизводится широкая диффузионная структура D, которая, согласно [18], происходит от мультиплета конечных состояний конфигурации Fe3d⁴.

В основном состоянии *R3c*-структуры местоположение Ві существенно разупорядочено так, что только 6 из 12 атомов кислорода, окружающих Ві, еще остаются ближайшими соседями [5]. Эти три лежащие в одной плоскости атома кислорода находятся на расстоянии 2.27 Å, а три других — на расстоянии 2.51 Å. Ближайший к атому железа атом висмута находится на расстоянии 3.06 Å, остальные — на расстояниях от 3.3 до 3.87 Å, т.е.



Рис. 4. Экспериментальный рентгеновский фотоэмиссионный спектр валентной полосы Fe₂O₃ после вычитания фона, со-поставленный с рассчитанными парциальными плотностями состояний валентной полосы.



Рис. 5. Экспериментальный рентгеновский фотоэмиссионный спектр монокристалла BiFeO₃ (1), сопоставленный с рассчитанной общей плотностью состояний валентной полосы (2).

их можно отнести ко второй координационной сфере. Тем не менее электронные состояния висмута вносят значительный вклад в форму валентной полосы.

На рис. 5 представлен экспериментальный рентгеноэлектронный спектр монокристалла феррита висмута без вычитания фона, сопоставленный с рассчитанной плотностью состояний, а на рис. 6 — рентгеноэлектронный спектр валентной полосы, исправленный на фон, в сопоставлении с парциальными плотностями состояния.

Как видно из сравнения рис. 3 и 5, рентгеноэлектронные спектры монокристаллов Fe₂O₃ и BiFeO₃ сильно различаются. Рентгеноэлектронный спектр валентной полосы BiFeO₃ (рис. 5) состоит из двух максимумов: низкоэнергетического в начале валентной полосы в области энергий от 0 до -8 eV и высокоэнергетического в области энергий от -8 до -12 eV. В области низкоэнергетического максимума рентгеноэлектронного спектра валентной полосы без фона на рис. 6 можно различить две детали тонкой структуры В и С, совпадающие по энергетическому положению с соответствующими особенностями в плотности состояний. Ширина по основанию низкоэнергетического максимума составляет 7.3 eV, а второго — 4.8 eV. Положение второго максимума относительно верха валентной полосы составляет 10.9 eV. Энергетическая протяженность валентной полосы, судя по рентгеноэлектронному спектру, равна 13.4 eV. Рассчитанная общая плотность состояний совмещена с экспериментальным спектром так, чтобы уровень Ферми, находящийся на краю плотности состояний, проходил через середину низкоэнергетического края валентной полосы. Энергетическая протяженность всей рассчитанной плотности состояний уже экспериментально определенной и равна 9.5 eV, причем рассчитанный второй максимум Е сдвинут относительно соответствующего экспериментального максимума на 0.5 eV в низкоэнергетическую сторону. Энергетическая протяженность низкоэнергетического максимума плотности состояний составляет 5.4 eV, что также уже низкоэнергетического максимума экспериментального спектра. Таким образом, расчет для BiFeO₃ приводит к несколько меньшим энергетическим значениям как общей ширины валентной полосы, так и отдельных ее участков, в частности энергетических протяженностей первого и второго максимумов, а также энергетических положений деталей тонкой структуры по сравнению с экспериментом. Рис. 6 позволяет более детально рассмотреть, из каких состояний формируются первый и вторые максимумы экспериментального спектра валентной полосы. Из рис. 6 видно, что в первый максимум вносят существенный вклад гибридизированные O2p- и Fe3d-электронные состояния. Вібя-состояния вносят вклад вблизи верха валентной полосы в области протяженностью около 1 eV. Второй максимум, согласно расчету, в основном представлен Bi6s-состояниями с небольшой примесью O2pсостояний. Данные нашего расчета хорошо коррелируют



Рис. 6. Экспериментальный рентгеновский фотоэмиссионный спектр валентной полосы BiFeO₃ после вычитания фона, сопоставленный с рассчитанными парциальными плотностями состояний валентной полосы.

с результами расчетов [5–8], которые включали Fe4s- и Віб*р*-состояния. Расчеты [5–8] показали, что вклад Fe4s- и Віб*р*-состояний в первый максимум исчезающе мал и не меняет общей формы всей плотности состояний.

Таким образом, несмотря на то что вклад от Вібр и Вібя в низкоэнергетический максимум плотности состояний BiFeO₃ мал по сравнению с вкладом от O2pи Fe3d-электронных состояний, а низкоэнергетический максимум, так же как и в Fe₂O₃, в основном формируется O2p- и Fe3d-электронными состояниями, формы рентгеноэлектронных спектров валентных полос обоих соединений сильно различаются. Сравнение полных и парциальных рассчитанных плотностей состояний обоих соединений показывает, что отсутствие ярко выраженной тонкой структуры в низкоэнергетическом максимуме экспериментального спектра BiFeO₃, скорее всего, определяется уменьшением энергетической протяженности деталей тонкой структуры в плотности состояний BiFeO₃, относящейся к этому максимуму, которая имеет место в рассчитанной плотности состояний BiFeO₃, по сравнению с Fe₂O₃. Представленные на рис. 3 и 5 полные плотности состояний для BiFeO3 и Fe2O3 обнаруживают три отчетливые особенности (A, B, C). Однако в BiFeO₃ пик А в плотности состояний, вклад в который дают Bi6s-состояния, сильно уменьшился по энергетической протяженности по сравнению с Fe₂O₃ (с 1.4 до 0.4 eV). Уменьшились также расстояния между деталями тонкой структуры А-В и В-С в ВіFeO3 по сравнению с Fe₂O₃, которые составляют, начиная с самого низкоэнергетического пика плотности состояний, соответственно 1.3, 1.7 eV и 2.4, 2.3 eV. Присутствие Bi6s-электронов в узкой области А на самом низкоэнергетическом краю валентной полосы, отстоящей достаточно далеко от основного пика E Bi6s-электронов, расположенного на расстоянии 9.3 eV от верха рассчитанной валентной полосы, является очень интересным. Аналогичную картину наблюдали авторы [35] в плотности состояний при расчете электронного строения *α*-Bi₂O₃. Область в начале плотности состояний 0-1.5 eV в *α*-Bi₂O₃ в [35] состоит из доминирующего пика О2*p*-состояний и примеси состояний Bi6s. В [35] показано, что эти состояния в целом формируют так называемую неподеленную пару Ві, играющую важную роль в осуществлении ионной проводимости материала α -Bi₂O₃. Как обсуждается в [5,6], эта неподеленная пара может играть большую роль в сегнетоэлектрических свойствах феррита висмута. Пик в плотности состояний феррита висмута в области 0-1 eV, состоящий в основном из О2р- и небольшой примеси Bi6s-состояний, по-видимому, может быть также отнесен к электронным состояниям, которые формируют неподеленную пару Ві в феррите висмута.

Таким образом, формально по своей трехпиковой структуре плотность состояний феррита висмута похожа на плотность состояний гематита, однако присутствие в сруктуре решетки висмута меняет физический смысл состояний в области $0-1 \, \text{eV}$ и приводит к общему сужению валентной полосы. Влияние висмута на две

другие структуры B и C сводится к их сближению и уменьшению энергетической протяженности, хотя доля Bi6*s*- и Bi6*p*-состояний в этой области мала и по данным наших расчетов, и по данным других авторов [5–8]. Однако уменьшение расстояний между пиками в плотности состояний BiFeO₃ и их менее яркая выраженность приводят к тому, что основной низкоэнергетический максимум BiFeO₃ в экспериментальном спектре обнаруживает только две детали тонкой структуры.

5. Заключение

Таким образом, в работе выращены монокристаллические образцы феррита висмута и гематита. Поверхности монокристаллов были подготовлены для фотоэмиссионного эксперимента скрайбированием в вакууме, так что элементный состав исследованной поверхности согласовывался с формульным для каждого образца. Контроль поверхности осуществлялся по форме рентгеноэлектронных линий Bi4 $f_{7/3,5/2}$, Fe $2p_{3/2,1/2}$, O1s-уровней и показал отсутствие посторонних фаз и загрязнений по кислороду и углероду. Получены рентгеноэлектронные спектры валентной области монокристаллических образцов BiFeO₃ и Fe₂O₃.

Проведенные *ab initio* расчеты полных и парциальных плотностей электронных состояний показали хорошее согласие теоретических и экспериментальных результатов.

Список литературы

- C. Michel, J.-M. Moreau, G.D. Achenbach, R. Gerson, W.J. James. Solid State Commun. 7, 701 (1969).
- [2] P. Fischer, M. Polomska, I. Sosnowska, M. Szymanski. J. Phys. C: Solid State Phys. 13, 1931 (1980).
- [3] Z.W. Wu, S. Gota, F. Jollet, M. Pollak, M. Gautier-Soyer, C.R. Natoli. Phys. Rev. B 55, 2570 (1997).
- [4] R.L. Blake, R.E. Hessevick. Am. Mineral. 51, 123 (1966).
- [5] J.B. Neaton, C. Ederer, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, K.M. Rabe. Phys. Rev. B 71, 014 113 (2005).
- [6] P. Ravindran, R. Vidya, A. Kjeksus, H. Fjellvåg. Phys. Rev. B 74, 224412 (2006).
- [7] H. Wang, Y. Zheng, M.-Q. Cai, H. Huang, H.L.W. Chan. Solid State Commun. 149, 641 (2009).
- [8] P. Baettig, C. Ederer, N.A. Spaldin. Phys. Rev. B 72, 214105 (2005).
- [9] T. Higuchi, Y.-S. Liu, P. Yao, P.A. Glans, J. Guo. Phys. Rev. B 78, 085 106 (2008).
- [10] P. Baettig, A. Spaldin. Appl. Phys. Lett. 86, 012 505 (2005).
- [11] T.-J. Park, S. Sambasivan, D.A. Fischer, W.-S. Yoon, J.A. Misewich, S.S. Wong, J. Phys. Chem. C 112, 10359 (2008).
- [12] C. Ederer, N.A. Spaldin. Phys. Rev. B 71, 224103 (2005).
- [13] А.Г. Гаврилюк, И.С. Любутин, В.В. Стружкин. Письма в ЖЭТФ 86, 604 (2007).
- [14] C. Colliex, T. Manoubi, C. Ortiz. Phys. Rev. B 44, 11402 (1991).
- [15] G. Rollmann, A. Rohrbach, P. Entel, J. Hafner. Phys. Rev. B 69, 165 107 (2004).

- [16] E. Thimsen, S. Biswag, C.S. Lo, P. Biswag. J. Phys. Chem. C 113, 2014 (2009).
- [17] K. Terakura, A.R. Williams, T. Oguchi, J. Kubler. Phys. Rev. Lett. 52, 1830 (1984).
- [18] A. Fujimori, M. Saeki, N. Kimizuka, M. Taniguchi, S. Suga. Phys. Rev. B 34, 7318 (1986).
- [19] Е.И. Сперанская, В.М. Скориков, Е.Я. Роде, В.А. Терехова. Извю АН СССР. Сер. хим. 5, 905 (1965).
- [20] R. Palai, R.S. Katiyar, H. Schmid, P. Tissot, S.J. Clark, J. Robertson, S.A.T. Redfern, G. Catalan, J.F. Scott. Phys. Rev. B 77, 014 110 (2008).
- [21] В.К. Ильин. ЖНХ 21, 1645 (1976).
- [22] В.С. Филипьев, Н.П. Смолянинов, Е.Г. Фесенко, И.Н. Беляев. Кристаллография 5, 959 (1960).
- [23] С.А. Федулов, Ю.Н. Веневцев, Г.С. Жданов, Е.Г. Смажевская. Кристаллография 6, 795 (1961).
- [24] T.T. Carvalho, P.B. Tavares. Mater. Lett. 62, 3984 (2008).
- [25] C. Tabares-Munoz. Ph D thesis N 2191. University of Geneva (1986).
- [26] R. Haumont, R. Saint-Martin, C. Byl. Phase Trans. 81, 881 (2008).
- [27] F. Kubel, H. Schmid. J. Cryst. Growth 129, 515 (1993).
- [28] Д.Н. Раков, В.А. Мурашов, А.А. Буш, Ю.Н. Веневцев. Кристаллография **33**, 445 (1988).
- [29] Z.V. Gabbasova, M.D. Kuz'min, A.K. Zvezdin, T.S. Dubenko, V.A. Murashov, D.N. Rakov, I.B. Krynetsky. Phys. Lett. A 158, 491 (1991).
- [30] A.E. Bocquet, A. Fujimori, T. Mizokawa, T. Saitoh, H. Namatame, S. Suga, N. Kimizuka, Y. Takeda, M. Takano. Phys. Rev. B 45, 1561 (1992).
- [31] W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. A 140, 1133 (1965).
- [32] S. Baroni, A. Dal Corso, S. de Gironcoli, P. Giannozzi, C. Cavazzoni, G. Ballabio, S. Scandolo, G. Chiarotti, P. Focher, A. Pasquarello, K. Laasonen, A. Trave, R. Car, N. Marzari, A. Kokalj. http://www.pwscf.or/.
- [33] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzherof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [34] J.H. Scofield. J. Electron Spectroscopy 8, 129 (1976).
- [35] A. Walsh, G.W. Watson, D.J. Payne, G. Edgell, J. Guo, P.-A. Glans, T. Learmonth, K.E. Smith. Phys. Rev. B 73, 235 104 (20060.